

■第29回応用物理学会 論文賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	講演タイトルならびに受賞者名
9/4 (火)	9:15 ~ 9:45	ZQ 5F-2501 2号館 (59)	(JJAP 論文賞) 生体分子のダイナミクスを可視化する高速 AMF 金沢大 ○安藤敏夫, 内橋貴之, 古寺哲幸, 宮城篤, 中北諒, 山下隼人, 坂下満
	10:00 ~ 10:30	B 1F-G102 G棟 (85)	(JJAP 論文賞) Carbon Nanotube Growth Technologies Using Tantalum Barrier Layer for Future ULSIs with Cu/Low-k Interconnect Processes 富士通研 堀部雅弘, 二瓶瑞久, 近藤大雄, 川端章夫, ○粟野祐二
9/5 (水)	13:00 ~ 13:20	T 3F-G304 G棟 (110)	(JJAP 論文奨励賞) Single-Walled Carbon Nanotube Thin-Film Sensor for Ultrasensitive Gas Detection 大阪大 ○Winadda Wongwiriyanan
	13:00 ~ 13:30	ZL 3F-2322 2号館 (54)	(JJAP 論文賞) Ferroelectricity Down to at Least 2 nm in Multiferroic BiFeO ₃ Epitaxial Thin Films CNRS/ ターレス物理学共同研 ¹ , パリ南大 ² H. Béa ¹ , S.Fusil ¹ , K. Bouzehouane ¹ , M. Bibes ² , M. Sirena ¹ , G. Herranz ¹ , E. Jacquet ¹ , J.-P. Contour ¹ , A. Barthélémy ¹
	13:00 ~ 13:30	D 1F-G104 G棟 (79)	(JJAP 論文賞) Hall Effect of Quasi-Hole Gas in Organic Single-Crystal Transistors 電力中研 ¹ , 理研 ² , 東北大 ³ ○竹谷純一 ¹ , 塚越一仁 ² , 青柳克信 ² , 竹延大志 ³ , 岩佐義宏 ³
	13:00 ~ 13:30	L 2F-G204 G棟 (95)	(JJAP 論文賞) Monolithic Implementation of Elemental Devices for Optoelectronic Integrated Circuit in Lattice-Matched Si/III-V-N Alloy Layers 豊橋技科大 ¹ , アルバイン ² , ルネサステクノロジ ³ ○古川雄三 ¹ , 米津英雄 ¹ , 森崎祐二 ² , 文秀榮 ¹ , 石地正義 ³ , 若原昭浩 ¹
	13:30 ~ 13:50	ZH 4F-G406 G棟 (70)	(JJAP 論文奨励賞) Superconducting Detector Array for Terahertz Imaging Applications 理研 ○有吉誠一郎
	13:45 ~ 14:05	Y 3F-G308 G棟 (49)	(JJAP 論文奨励賞) 超短光パルスを用いた透明材料のマイクロ溶接 大阪大 ○玉木隆幸
	15:15 ~ 15:35	V 3F-G305 G棟 (61)	(JJAP 論文奨励賞) Hard X-Ray Nano-Interferometer and Its Application to High-Spatial-Resolution Phase Tomography 兵庫県立大 ○小山貴久
9/6 (木)	9:00 ~ 9:30	ZR 1F-5106 5号館 (99)	(JJAP 論文賞) Room-Temperature Stimulated Emission from AlN at 214 nm 南カロライナ大 Maxim Shatalov, Mikhail Gaevski, Vinod Adivarahan, Asif Khan
	13:00 ~ 13:30	B 1F-G102 G棟 (75)	(解説論文賞) Bent-Core Liquid Crystals: Their Mysterious and Attractive World 東京工業大 ○竹添秀男, 高西陽一
	13:15 ~ 13:35	ZF 4F-G405 G棟 (82)	(JJAP 論文奨励賞) Rate-Limiting Reactions of Growth and Decomposition Kinetics of Very Thin Oxides on Si(001) Surfaces Studied by Reflection High-Energy Electron Diffraction Combined with Auger Electron Spectroscopy 東北大 ○小川修一
	14:00 ~ 14:30	ZM 3F-2323 2号館 (84)	(JJAP 論文賞) Modified Oxygen Vacancy Induced Fermi Level Pinning Model Extendable to P-Metal Pinning 半導体テクノ ¹ , 筑波大 ² , 物・材機構 ³ ○赤坂泰志 ¹ , 中村源志 ¹ , 白石賢二 ² , 梅澤直人 ³ , 山辺紀久夫 ² , 小川修 ¹ , 李明範 ¹ , 網中利夫 ¹ , 粕谷透 ¹ , 渡部平司 ¹ , 知京豊裕 ³ , 大塚文雄 ¹ , 奈良安雄 ¹ , 中村邦雄 ¹
	15:45 ~ 16:15	V 3F-G305 G棟 (39)	(JJAP 論文賞) A Super-Precise CTE Evaluation Method for Ultra-Low-Expansion Glasses Using the LFB Ultrasonic Material Characterization System 東北大 ○櫛引淳一, 荒川元孝, 大橋雄二, 鈴木光二, 丸山貴久
9/7 (金)	9:00 ~ 9:30	ZR 1F-5106 5号館 (100)	(JJAP 論文賞) Blue, Green, and Amber InGaN/GaN Light-Emitting Diodes on Semipolar[1122] GaN Bulk Substrates 京都市大 ¹ , 日亜化学 ² ○船戸充 ¹ , 上田雅也 ¹ , 川上義一 ¹ , 成川幸男 ² , 小杉卓生 ² , 高橋正良 ² , 向井孝志 ²
	11:30 ~ 11:50	S 3F-G303 G棟 (109)	(JJAP 論文奨励賞) Half-Metallic Properties in Co ₂ MnSi Full-Heusler Alloy 東北大 ○桜庭裕弥
	11:50 ~ 12:10	S 3F-G303 G棟 (109)	(JJAP 論文奨励賞) Investigation of Spin Voltaic Effect in a p-n Heterojunction 東京工業大 ○近藤剛
	13:00 ~ 13:30	S 3F-G303 G棟 (109)	(JJAP 論文賞) Spin-Dependent Transport in C ₆₀ -Co Nano-Composites 大阪大 三輪真嗣, ○白石誠司, 水口将輝, 新庄輝也, 鈴木義茂
	13:30 ~ 13:50	ZH 4F-G406 G棟 (69)	(JJAP 論文奨励賞) Enhancement of Flux-Pinning in Epitaxial Sm _{1-x} Ba _{2x} Cu ₃ O _y Films by Introduction of Low-T _c Nanoparticles 名古屋大 ○三浦正志
	14:00 ~ 14:30	ZL 3F-2322 2号館 (88)	(解説論文賞) Si系高移動度 MOS トランジスタ技術 東京大 ○高木信一
	15:45 ~ 16:15	V 3F-G305 G棟 (40)	(解説論文賞) 21世紀の国際単位と標準 東京理科大 ○盛永篤郎

*論文賞受賞記念講演は日程の都合で講演取消になる場合があります。

() 内の数字はプログラム掲載頁。

■第22回(2007年春季)応用物理学会 講演奨励賞 賞状・記念品の贈呈式

標記贈呈式を下記により公開で行います。ふるってご参加ください。

日時： 9月4日(火) 12:00～12:45

会場： 北海道工業大学 G棟 1F-G103 (C会場)

講演奨励賞受賞者 (講演時の所属)	講演題目 (受賞者以外の共著者の所属：共著者)	講演奨励賞受賞者 (講演時の所属)	講演題目 (受賞者以外の共著者の所属：共著者)
濱岡 福太郎* (慶大理工)	SF ₆ /O ₂ 2周波容量結合プラズマによる Si-MEMS 加工のモデリング(1) (慶大理工：八木澤卓, 真壁利明)	丸山 結城* (豊橋技科大)	フィルタレス蛍光検出センサを用いた二本鎖 DNA の定量分析およびリアルタイム蛍光検出 (豊橋技科大 ¹ , JST CREST ² , ISSRC ³ : 高橋英邦 ^{2,3} , 澤田和明 ^{1,2,3} , 石田 誠 ^{1,2,3})
富田 健太郎* (九大総理工)	協同的トムソン散乱による EUV 光源用放電生成プラズマの計測 (九大総理工 ¹ : 熊大自然科学研究科 ² : 荒木俊二 ¹ , 山田貴夫 ¹ , 香川敦祐 ¹ , 内野喜一郎 ¹ , 今村秀樹 ² , 勝木 淳 ² , 秋山秀典 ²)	金 起範* (東工大応セラ研)	C12A7:e/Alq ₃ 界面の電子注入特性と閾値電圧の低電圧化 (東工大応セラ研 ¹ , JST ² , 東工大フロンティア ³ : 菊池麻依子 ¹ , 宮川仁 ³ , 柳博 ¹ , 神谷利夫 ^{1,2} , 平野正浩 ² , 細野秀雄 ^{1,2,3})
宮野 一輝* (阪大院工)	多孔質イオン交換膜を用いた細菌センシングの解析 (阪大院工 ¹ , 大阪府立産技研 ² : 堀田沙織 ¹ , 青木秀允 ¹ , 藤原信明 ² , 木村千春 ¹ , 杉野 隆 ¹)	尾崎 良太郎* (防衛大)	弾性表面波型デバイス中の液晶配向変化により生じる伝搬位相変化の解析 (防衛大 ¹ , 島根大 ² , 武蔵工大 ³ : 青木 仁 ¹ , 吉野勝美 ² , 戸田耕司 ³ , 森武 洋 ¹)
谷口 純* (阪大院基礎工)	拡散光による高濃度コロイド溶液に含まれるナノ粒子の粒径と数密度の計測 (阪大院基礎工：村田博司, 岡村康行)	関谷 毅* (東工大)	有機トランジスタとプラスチック接点スイッチを用いたワイヤレス電力伝送シート (東工大 ¹ , 東大 VDEC ² , 東大国際産学 ³ : 高宮 真 ² , 野口儀兒 ¹ , 中野慎太郎 ¹ , 加藤祐作 ¹ , 比津和樹 ¹ , 桜井貴康 ³ , 染谷隆夫 ¹)
平塚 洋二郎 (横国大工)	光駆動ローリングマイクロマニピュレータの開発 (横国大工 ¹ , JST さきがけ ² : 丸尾昭二 ^{1,2})	Sanjeeva Dissanayake* (東工大)	酸化濃縮法により作製された超薄膜(110)面 GOI p-MOSFET (東工大 ¹ , 東大新 ² , 東工大理工 ³ : 熊谷 寛 ² , 周藤悠介 ¹ , 菅原 聡 ³ , 高木信一 ^{1,2})
沖田 昌仁* (筑波大物理工)	半導体レーザー側面励起 Nd:YVO ₄ 1.3μm レーザーにおけるラゲルガウスビーム発生 (筑波大物理工 ¹ , 千葉大工 ² , JST PRESTO ³ : 登内章博 ² , 伊藤雅英 ¹ , 谷田貝豊彦 ^{2,3} , 尾松孝茂 ^{2,3})	田中 洋毅* (東芝研開セ)	TEM-EELS 法によるゲート/絶縁膜を構成する重元素の局所的な結合状態分析 (東芝研開セ：市原玲華, 土屋義規, 小山正人, 竹野史郎)
河野 行雄* (理研, JST PRESTO)	カーボンナノチューブ量子ドットにおけるテラヘルツ光子サイドバンドの観測 (理研 ¹ , 東工大総理工 ² , JST CREST ³ : 布施智子 ^{1,2} , 内田剛生 ^{1,2} , 石橋幸治 ^{1,3})	桑原 啓* (NTT MI 研)	RF CMOS-MEMS の検討(1): RF MEMS 技術と RF CMOS 技術の融合 (NTT MI 研 ¹ , NTT-AT ² : 佐藤昇男 ¹ , 島村俊重 ¹ , 森村浩季 ¹ , 小箱淳一 ¹ , 重松智志 ¹ , 中西 衛 ¹ , 亀井敏和 ² , 町田克之 ² , 石井 仁 ¹)
渡邊 紳一 (東大理)	高空間分解能を有する超小型テラヘルツ分光装置の開発 (東大理：島野 亮)	草山 育実* (慶大理工)	交互吸着法による多段階発光 YAG:Ce ³⁺ ナノ粒子/PMMA 複合ビーズの作製と生体分子検出への応用 (慶大理工 ¹ , 滋賀医大 ² , 古河電工 ³ : 朝倉 亮 ¹ , 齊藤大輔 ¹ , 磯部徹彦 ¹ , 黒川 清 ² , 会澤英樹 ³ , 高木智洋 ³ , 平山陽介 ³ , 大久保典雄 ³)
武吉 佑祐* (慶大理工)	パラレル光インターコネクットのための屈折率分布型 4ch ポリマー光導波路 (慶大理工：石樽崇明)	上田 公二* (九大院システム情報)	Fe ₃ Si/SiGe ヘテロエピタキシャル成長に与える基板効果 (九大院システム情報 ¹ , 京大院エネルギー科学 ² : 熊野 守 ¹ , 権丈 淳 ¹ , 佐達泰造 ¹ , 前田佳均 ² , 宮尾正信 ¹)
笹川 清隆* (情通機構)	PPMgLN ディスク型光共振器による第三高調波発生 (情通機構：土屋昌弘)	石塚 尚吾 (産総研太陽光)	Se ラジカル源を用いた Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ 薄膜の作製と太陽電池特性 (産総研太陽光 ¹ , 産総研エレ ² : 柴田 肇 ² , 山田昭政 ¹ , 櫻井啓一郎 ¹ , 松原浩司 ¹ , 仁木 栄 ¹)
柴田 俊明* (東北大院工)	ダイヤモンドライクカーボンの構造及び摩擦特性に関する計算化学的研究 (東北大院工 ¹ , JST さきがけ ² , 東北大未来センター ³ : 三浦隆治 ¹ , 坪井秀行 ¹ , 古山通久 ¹ , 畠山望 ¹ , 遠藤明 ¹ , 高羽洋充 ¹ , 久保百司 ^{1,2} , Carlos A. Del Carpio ¹ , 宮本 明 ^{1,3})	星乃 紀博* (JAXA 宇宙研, 東大院工)	4H-SiC エピ層中の積層欠陥の室温 PL マッピング評価 (JAXA 宇宙研 ¹ , 東大院工 ² , デンソー ³ : 田島道夫 ^{1,2} , 内藤正美 ³ , 恩田正一 ³)
米谷 匡司* (姫路工大)	走査型非線形誘電率顕微鏡による PbTiO ₃ 極薄膜のドメイン構造の観察 (姫路工大 ¹ , 兵庫県大工 ² : 高島慶行 ² , 堀井 通 ² , 藤沢浩訓 ^{1,2} , 清水 勝 ^{1,2})	巨野 克典 (京大院工)	4H-SiC におけるキャリア寿命制限因子の検討とキャリア寿命制御の試み (京大院工 ¹ , 豊田中研 ² : 中村大輔 ² , 木本恒暢 ¹)
山下 隼人* (金沢大自然科学)	レーザー照射による AFM カンチレバーの直接駆動 (金沢大自然科学 ¹ , JST CREST ² : 内橋貴之 ^{1,2} , 古寺哲幸 ¹ , 宮城 篤 ¹ , 山本大輔 ² , 安藤敏夫 ^{1,2})	上田 雅也* (京大院工)	半極性(11-22) GaN パルク基板上 InGaN/GaN 発光ダイオードの偏光特性 (京大院工 ¹ , 日亜化学 ² : 船戸 充 ¹ , 川上養一 ¹ , 成川幸男 ² , 向井孝志 ²)
疋田 育之* (東大新領域)	SrRuO ₃ /Nb:SrTiO ₃ (100) Schottky 接合の内部光電効果測定 (東大新領域 ¹ , JST さきがけ ² : 須崎友文 ¹ , 高木英典 ¹ , Harold Y. Hwang ^{1,2})	赤羽 浩一* (情通機構)	Si(001) 基板上面発光デバイスに向けた AlGaSb/AlSb DBR 構造の作製 (情通機構：山本直克, 牛頭信一郎, 上田章雄, 土屋昌弘)
沼波 政倫* (阪大レーザー研)	レーザー生成プラズマの強磁場中における膨張 (阪大レーザー研：高田 明, 西原功修)	大平 圭介 (北陸先端大)	フラッシュランブアニールによるアモルファスシリコン薄膜の面内均一結晶化 (北陸先端大 ¹ , ウシオ電機 ² : 遠藤洋平 ² , 藤原友子 ¹ , 西崎昭吾 ¹ , 柄沢 武 ² , 鳥飼哲哉 ² , 松村英樹 ¹)
吉森 宏雅* (阪大院工)	透過型電子顕微鏡における動的ホローコーン照明による位相・振幅成分の分離再生 (阪大院工 ¹ , 大阪電通大 ² : 田屋昌樹 ¹ , 生田孝 ² , 高井義造 ¹)	島田 保 (東大院新領域)	弱磁性微粒子の磁場配向過程のその場観察 (東大院新領域 ¹ , 物材機構 ² : 廣田憲之 ² , 安藤 努 ¹ , 目 義雄 ² , 和田 仁 ¹)
石井 大基* (太陽誘電)	MgO 添加 (Ba,Sr)TiO ₃ 薄膜の GHz 帯域におけるチューナブル特性 (太陽誘電：岩崎啓志紀, 森戸健太郎, 鈴木利昌, 岸 弘志)	浜生 宏平* (東大生研)	単一 InAs 量子ドット/強磁性電極二重トンネル接合におけるスピン伝導 (東大生研 ¹ , 東工大応セラ研 ² , 東大先端研 ³ : 北島未来 ¹ , 増淵 覚 ¹ , 川村 稔 ¹ , M. Jung ¹ , 柴田憲治 ¹ , 平川一彦 ¹ , 谷山智康 ² , 石田悟己 ³ , 荒川泰彦 ^{1,3} , 町田友樹 ¹)
難波 雅史* (東北大金研強磁場センター)	BaZrO ₃ 添加 YBa ₂ Cu ₃ O _{7-x} 膜の磁束相図 (東北大金研強磁場センター ¹ , 京大工 ² , 名大工 ³ , 九大工 ⁴ , 東大工 ⁵ , 電中研 ⁶ , 静大工 ⁷ , JST CREST ⁸ : 淡路 智 ¹ , 渡辺和雄 ¹ , 堀出朋哉 ^{2,8} , Mele Paolo ^{2,8} , 松本 要 ^{2,8} , 吉田 隆 ^{3,8} , 向田昌志 ^{4,8} , 堀井 滋 ^{5,8} , 一瀬 中 ^{6,8} , 喜多隆介 ^{7,8})	牧 英之* (慶大理工)	孤立カーボンナノチューブ引張り印加素子の開発および発光・形態の直接観察 (慶大理工 ¹ , 理研 ² : 佐藤徹哉 ¹ , 石橋幸治 ²)
桂 ゆかり* (東大院工)	MgB ₂ 超伝導体への希土類元素置換効果 (東大院工：岩山 功, 山本明保, 花房 慶, 堀井 滋, 下山淳一, 岸尾光二)	川原村 敏幸* (京大院工電子)	Fine Channel Mist CVD 法による単結晶 ZnO 薄膜の作製 (京大院工電子 ¹ , セラミックフォーラム ² , 京大 IIC ³ : 西中浩之 ¹ , 増田喜男 ² , 藤田静雄 ³)
平野 裕美子* (東大生研)	レーザーピックアップ法によるゲルの表面張力測定 (東大生研：美谷周二朗, 酒井啓司, 高木堅志郎)		

※：講演奨励賞受賞記念講演有 (p.5 参照)

■第22回応用物理学会 講演奨励賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	中分類科名, 講演タイトルならびに講演者名
9/4 (火)	9:00 ~ 9:15	ZQ 5F-2501	6.5 表面物理・真空 レーザー照射によるカンチレバーの直接駆動を用いた高速 AFM の距離制御 金沢大自然科学 ¹ , JST-CREST ² ○山下卓人 ¹ , 内橋貴之 ^{1,2} , 古寺哲幸 ² , 宮城 篤 ¹ , 山本大輔 ² , 安藤敏夫 ^{1,2}
	13:30 ~ 13:45	V 3F-G305	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析 透過型電子顕微鏡における動的ホローコーン照明を用いた波動場再生 阪大理工 ¹ , 大阪電通大 ² ○吉森宏雅 ¹ , 田屋昌樹 ^{1,2} , 生田 孝 ² , 高井義造 ¹
9/5 (水)	9:30 ~ 9:45	ZA 3F-GF309	1.7 プラズマエッチング SF ₆ /O ₂ 周波数結合プラズマによる Si-MEMS 加工のモデリング (II) 慶大理工 ¹ ○濱岡福太郎, 八木澤 卓, 真壁利明
	10:30 ~ 10:45	H 2F-G202	10.6 高分子・ソフトマテリアル レーザービクアップ法によるゲル表面波測定 東京電機大 ¹ , 東大生研 ² ○平野 (古武) 裕美子 ¹ , 酒井啓司 ² , 高木堅志郎 ²
	13:00 ~ 13:15	F 2F-G201	6.2 カーボン系薄膜 ダイヤモンドライクカーボンの摩擦特性解明のための新規計算化学手法の開発 東北大院工 ¹ , 東北大未来センター ² ○柴田俊明 ¹ , 森田祐輔 ¹ , 三浦隆治 ¹ , Sahnoun Riadh ¹ , 古山通久 ¹ , 坪井秀行 ¹ , 畠山 望 ¹ , 遠藤 明 ¹ , 高羽洋充 ¹ , 久保百司 ¹ , Carlos A. Del Carpio ¹ , 宮本 明 ^{1,2}
	13:00 ~ 13:15	Q 2F-G207	12.1 探索的材料物性 強磁性体シリサイド (Fe,Si)/半導体 (Ge) ヘテロ界面の原子層制御 九大 ¹ , 原研機構先端基礎 ² , 京大 ³ ○上田公二, 熊野 守 ¹ , 安藤裕一郎 ¹ , 佐道泰造 ¹ , 鳴海一雅 ² , 前田佳均 ^{2,3} , 宮尾正信 ¹
	13:30 ~ 13:45	L 2F-G204	12.5 半導体光物性・光デバイス フローサイトメータを利用した YAG:Ce ³⁺ ナノ粒子複合蛍光ビーズによる生体分子検出 慶大理工 ¹ , 環太平洋大 ² , 古河電工 ³ ○草山育実 ¹ , 朝倉 亮 ¹ , 齊藤大輔 ¹ , 磯部敬彦 ¹ , 黒川 清 ² , 会澤英樹 ³ , 高木智洋 ³ , 平山陽介 ³ , 大久保典雄 ³
	13:30 ~ 13:45	ZK 4F-G407	8.2 誘電材料・誘電体 (Ba,Sr)TiO ₃ 薄膜の GHz 帯域におけるチューナブル特性改善 太陽誘電 ¹ ○石井大基, 岩崎蒼志紀, 森戸健太郎, 鈴木利昌, 水野洋一
	13:30 ~ 13:45	ZF 4F-G405	11.1 基礎物性・評価 ゲート/絶縁膜に用いられる重元素の TEM-EELS による局所的な結合状態分析 東芝研究開発セ ¹ ○田中洋毅, 市原玲華, 土屋義規, 小山正人, 竹野史郎
	15:45 ~ 16:00	S 3F-G303	合同セッション E 「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 強磁性電極を有する単電子トランジスタにおけるトンネル磁気抵抗効果の電界制御 東大生研 ¹ , 東大先端研 ² , 東工大応セラ研 ³ , 東大ナノ量子機構 ⁴ ○浜屋宏平 ¹ , 北島未来 ¹ , 柴田憲治 ¹ , M. Jung ¹ , 川村 稔 ¹ , 石田悟己 ² , 谷山智康 ³ , 平川一彦 ^{1,4} , 荒川泰彦 ^{1,2,4} , 町田友樹 ^{1,4}
	15:50 ~ 16:05	V 3F-G305	7.1 X線技術 LPP-EUV 光源におけるイオンデプリーの磁場シールドに関する PIC シミュレーション 阪大レーザー研 ¹ ○沼波政倫, 高田 明, 西原功修
	16:15 ~ 16:30	ZL 3F-2322	6.1 強誘電体薄膜 走査型非線形誘電率顕微鏡による PbTiO ₃ 極薄膜のドメイン構造の観察 兵庫県立大 ¹ ○米谷匡司, 高島慶行, 堀井 通, 藤沢浩訓, 清水 勝
9/6 (木)	13:00 ~ 13:15	N 2F-G206	5.4 光制御 PPMgLN デバイス型光共振器による cw 励起第三高調波発生 情通機構 ¹ ○笹川清隆, 土屋昌弘
	13:00 ~ 13:15	A 1F-G101	10.7 生物・医用工学・バイオチップ フィルタレス蛍光検出センサによる DNA 増幅過程のリアルタイムモニタリング 豊技大 ¹ , JST-CREST ² , JSPS ³ ○丸山結城 ^{1,2} , 高尾英邦 ^{1,2} , 澤田和明 ^{1,2} , 石田 誠 ^{1,2}
	13:00 ~ 13:15	ZS 2F-5202	13.4 III - V 窒化物結晶 半導性 (11-22) GaN バルク基板上 InGa _{0.15} N/GaN 量子井戸活性層の偏光特性 京大院工 ¹ , 日亜化学 ² ○上田雅也 ¹ , 船戸 充 ¹ , 川上養一 ¹ , 成川幸男 ² , 向井孝志 ²
	13:00 ~ 13:15	T 3F-G304	合同セッション F 「カーボンナノチューブの基礎と応用」 一軸引張り歪印加による孤立単層カーボンナノチューブのバンドギャップ連続制御 慶大理工 ¹ , 理研 ² ○牧 英之 ¹ , 佐藤徹哉 ¹ , 石橋幸治 ²
	13:15 ~ 13:30	N 2F-G206	5.4 光制御 屈折率分布型 4ch ポリマー光導波路のクロストークおよびスキュー特性解析 慶大院理工研 ¹ ○武吉祐祐, 石橋崇明
	13:30 ~ 13:45	B 1F-G102	10.5 液晶 弾性波の伝搬位相変化を利用した液晶の粘性変化の測定とその解析 防衛大 ¹ , 島根大 ² , 武蔵工大 ³ ○尾崎良太郎 ¹ , 青木 仁 ¹ , 吉野勝美 ² , 戸田耕司 ³ , 森武 洋 ¹
	13:30 ~ 13:45	ZH 4F-G406	9.3 薄膜, 厚膜, チューブ作製プロセスおよび結晶成長 異なる c 軸相関ピンが磁束ピンニング状態図に及ぼす影響 東北大生研 ¹ , 原子力機構 ² , 京大工 ³ , 九工大工 ⁴ , 名大工 ⁵ , 九大工 ⁶ , 東大工 ⁷ , 電中研 ⁸ , CREST-JST ⁹ ○難波波史 ¹ , 淡路 智 ¹ , 渡辺和雄 ¹ , 野島 勉 ¹ , 岡安 悟 ² , 堀田朋哉 ^{3,9} , メレバオロ ^{4,9} , 松本 要 ^{4,9} , 三浦正志 ^{5,9} , 一野祐亮 ^{5,9} , 吉田 隆 ^{5,9} , 高井吉明 ⁵ , 向田昌志 ^{6,9} , 堀井 滋 ^{7,9} , 一瀬 中 ^{8,9}
13:30 ~ 13:45	ZN 4F-2401	13.6 IV 族系化合物 室温 PL マッピングによる 4H-SiC エピ層中の積層欠陥の評価 JAXA 宇宙研 ¹ , 東大院工 ² , デンソー ³ ○星乃紀博 ^{1,2} , 田島道夫 ^{1,2} , 内藤正美 ³ , 奥野英一 ³ , 恩田正一 ³	
9/7 (金)	9:00 ~ 9:15	ZQ 5F-2501	合同セッション K 「酸化亜鉛系機能性材料」 Fine Channel Mist CVD 法による単結晶 ZnO 薄膜の作製 (2) 京大院工電子 ¹ , 京大 IIC ² ○川原利敏幸 ¹ , 西中浩之 ¹ , 藤田静雄 ²
	9:30 ~ 9:45	X 3F-G307	3.1 物理光学・光学基礎 拡散光による高濃度コロイド溶液に含まれるナノ粒子の粒径と数密度の計測とその応用 阪大院基礎工 ¹ ○谷口 純, 村田博司, 岡村康行
	12:15 ~ 12:30	V 3F-G305	2.1 計測・制御技術 多孔質イオン交換膜を用いた細菌のセンシング 阪大院工 ¹ , 大阪府立産技研 ² ○宮野一輝 ¹ , 堀田紗織 ¹ , 青木秀充 ¹ , 藤原信明 ² , 木村千春 ¹ , 杉野 隆 ¹
	13:30 ~ 13:45	ZB 4F-G401	4.5 テラヘルツ全般・非線形光学 カーボンナノチューブ量子ドットを用いた周波数可変テラヘルツ光子センシング 理研 ¹ , JST さきがけ ² , 東京理科大 ³ , JST CREST ⁴ ○河野行雄 ^{1,3} , 豊川聖子 ^{1,3} , 布施智子 ¹ , 内田剛生 ¹ , 石橋幸治 ^{1,4}
	13:50 ~ 14:05	ZH 4F-G406	9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用 新規ホウ化物超伝導体の探索 -MgB ₂ への元素置換研究からの発展- 東大院工 ¹ ○桂 ゆかり, 松村友多佳, 狛野 拓, 堀井 滋, 下山淳一, 岸尾光二
	14:00 ~ 14:15	ZT 2F-5023	6.3 酸化物エレクトロニクス SrRuO ₃ /Nb:SrTiO ₃ (100) Schottky 接合の内部光電効果測定 東大新領域 ¹ , JST ² ○足田育之 ¹ , 須崎友文 ¹ , 高木英典 ¹ , ハロルドファン ^{1,2}
	14:30 ~ 14:45	ZL 3F-2322	11.6 Si デバイス/集積化技術 酸化濃縮法による (110) 面超薄膜 GOIP-MOSFET デバイス作成 東大工 ¹ , 東大新 ² , 東工大 ³ ○Sanjeeva Dissanayake ¹ , Hiroshi Kumagai ¹ , Yusuke Shuto ¹ , Satoshi Sugahara ² , Shinichi Takagi ^{1,2}
	15:30 ~ 15:45	B 1F-G102	10.2 評価・基礎物性 C12A7:e/Alq ₃ 界面の電子注入特性と閾値電圧の低電圧化 東大応セラ研 ¹ , JST, 東工大フロンティア ² ○金 起範 ¹ , 菊池麻依子 ¹ , 宮川 仁 ³ , 柳 博 ¹ , 神谷利夫 ^{1,2} , 平野正浩 ² , 細野秀雄 ^{1,2,3}
	15:45 ~ 16:00	E 1F-G101	13.3 III - V 族エピタキシャル結晶 Si(001) 基板上における Sb 系化合物半導体結晶成長と光デバイスへの応用 情通機構 ¹ ○赤羽浩一, 山本直克, 土屋昌弘
	17:00 ~ 17:15	ZL 3F-2322	11.6 Si デバイス/集積化技術 シングルチップ RF LSI の実現に向けた RF CMOS-MEMS 技術の構築 NTT MI 研 ¹ , NTT AT ² ○桑原 啓 ¹ , 佐藤昇男 ¹ , 島村俊重 ¹ , 森村浩季 ¹ , 小笠淳一 ¹ , 重松智志 ¹ , 中西 衛 ¹ , 亀井敏和 ² , 町田克之 ² , 石井 仁 ¹
9/8 (土)	9:00 ~ 9:15	D 1F-G104	10.9 特定テーマ A 有機トランジスタ 印刷技術を用いた有機トランジスタ・接点スイッチと大面積ワイヤレス電力伝送シート 東大工 ¹ , 東大 VDEC ² , 東大国際学 ³ ○関谷 毅 ¹ , 野口儀晃 ¹ , 中野慎太郎 ¹ , 加藤祐作 ¹ , 高宮 真 ² , 桜井貴康 ² , 染谷隆夫 ¹
	10:30 ~ 10:45	ZD 4F-G403	1.3 反応性プラズマの診断と計測 協同的トムソン散乱による EUV 光源用プラズマの計測 九大総理工 ¹ , 熊大自然科学研究科 ² ○富田健太郎 ¹ , 山田貴夫 ¹ , 香川敦祐 ¹ , 内野喜一郎 ¹ , 勝木 淳 ² , 秋山秀典 ²
	12:45 ~ 13:00	F 2F-G201	4.3 レーザー装置・材料 半導体レーザー側面励起 Nd バナデイトパウンズレーザーにおける高出力ラゲルカウスビーム発生 千葉大院融合 ¹ , 筑波大理工 ² , PRESTO-JST ³ ○沖田昌仁 ¹ , 林 穂 ¹ , 伊藤雅英 ² , 谷田貝豊彦 ² , 尾松孝茂 ^{1,3}